

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Якимов Евгений Борисович
2	Дата рождения (полная)	17.11.1947
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук (специальность 01.04.10 – «Физика полупроводников и диэлектриков»)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор (по кафедре)
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Институтская, д. 6 http://www.iptm.ru eagle@iptm.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук
	Ведомственная принадлежность организации	РАН
	Тип организации	НИИ
	Наименование подразделения	Лаборатория локальной диагностики полупроводниковых материалов
	Должность	Главный научный сотрудник
7	Основные публикации в области диссертационного исследования	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Y.O. Kulanchikov, P.S. Vergeles, D.S. Saranin, A.R. Ishteev, D.S. Muratov, E.E. Yakimov, E.B. Yakimov, Aldo Di Carlo. Decomposition of MAPbBr₃ single crystals under electron beam irradiation //Journal of Luminescence. – 2025. – Т. 279. – С. 121049. DOI 10.1016/j.jlumin.2024.121049. 2. Yu. O. Kulanchikov, P.S. Vergeles, K. Konstantinova, A.R. Ishteev, D.S. Muratov, E.E. Yakimov, E.B. Yakimov, D.S. Saranin. MAPbBr₃ monocrystals under electron beam radiolysis and degradation revealed by cathodoluminescence spectroscopy //arXiv preprint arXiv:2305.06783. – 2023. DOI 10.48550/arXiv.2305.06783 3. Polyakov A.Y., Yakimov E.B., Shchemerov I.V., Vasilev A.A., Kochkova A.I., Nikolaev V.I., Pearton S.J. Huge photosensitivity gain combined with long photocurrent decay times in various polymorphs of Ga₂O₃: effects of carrier trapping with deep centers // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2025. – Т. 58. – № 6. – P. 063002. DOI 10.1088/1361-6463/ad8e6e. 4. Polyakov A.Y., Saranin D.S., Shchemerov I.V., Vasilev A.A., Romanov A.A., Kochkova A.I., Gostischev P., Chernykh A.V., Alexanyan L.A., Matros N.R., Lagov P.B., Doroshkevich A.S., Isayev R.Sh., Pavlov Yu.S., Kislyuk A.M., Yakimov E.B., Pearton S.J. Proton irradiation of Ga₂O₃ Schottky diodes and NiO/Ga₂O₃ heterojunctions // Scientific Reports. – 2024. – Т. 14. – № 1. – P. 27936. DOI 10.1038/s41598-024-78531-y. 5. Polyakov A.Y., Vasilev A.A., Kochkova A.I., Shchemerov I.V., Yakimov E.B., Miakonkikh A.V., Chernykh A.V., Lagov P.B., Pavlov Y.S., Doroshkevich A.S., Isaev R.Sh., Romanov A.A., Alexanyan L.A., Matros N., Azarov A., Kuznetsov A., Pearton S. Proton damage effects in double polymorph γ/β- Ga₂O₃ diodes // Journal of Materials Chemistry C. – 2024. – Т. 12. – № 3. – P. 1020–1029. 	

DOI 10.1039/d3tc04171a.

6. Николаев В.И., Поляков А.Я., Степанов С.И., Печников А.И., Николаев В.В., **Якимов Е.Б.**, Щеглов М.П., Чикиряка А.В., Гузилова Л.И., Тимашов Р.Б., Шапенков С.В., Бутенко П.Н. Рекордно толстые эпитаксиальные слои $\kappa(\epsilon)$ -Ga₂O₃, выращенные на GaN/-сапфире // Журнал Технической Физики. – 2023. – Т. 93. – № 3. – С. 403–408.
DOI 10.21883/JTF.2023.03.54853.231-22/
7. **Yakimov E.B.**, Nikolaev V.I., Pechnikov A.I., Polyakov A.Y., Shchemerov I.V., Vasilev A.A., Kulanchikov Y.O., Vergeles P.S., Yakimov E.E., Pearton S.J. Electron beam induced current study of photocurrent gain in κ -Ga₂O₃ schottky diodes // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2023. – Т. 12. – № 4. – P. 0440091.
DOI 10.1149/2162-8777/acce6d.
8. Polyakov A.Y., Almaev A.V., Nikolaev V.I., Pechnikov A.I., Shchemerov V.I., Vasilev A.A., **Yakimov E.B.**, Kochkova A.I., Kopyev V.V., Kushnarev B.O., Pearton S.J. Mechanism for long photocurrent time constants in α -Ga₂O₃ UV photodetectors // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2023. – Т. 12. – № 4. – P. 045002.
DOI 10.1149/2162-8777/acc900.
9. **Yakimov E.B.**, Polyakov A.Y., Nikolaev V.I., Pechnikov A.I., Scheglov M.P., Yakimov E.E., Pearton S.J. Electrical and recombination properties of polar orthorhombic κ -Ga₂O₃ films prepared by halide vapor phase epitaxy // Nanomaterials. – 2023. – Т. 13. – № 7. – P. 044009.
DOI 10.3390/nano13071214.
10. Dorokhin M.V., Vikhrova O.V., Demina P.B., Kalentyeva I.L., Lesnikov V.P., Zvonkov B.N., Ved M.V., Danilov Y.A., Zdoroveyshchev A.V., Vergeles P.S., **Yakimov E.B.** GaAs diodes for TiT₂-based betavoltaic cells // Applied Radiation and Isotopes. – 2022. – Т. 179. – P. 110030.
DOI 10.1016/j.apradiso.2021.110030.
11. Polyakov A.Y., **Yakimov E.B.**, Shchemerov I.V., Vasilev A.A., Kochkova A.A., Chernykh A.V., Nikolaev V.I., Pechnikov A.I., Stepanov S.I., Scheglov M.P., Chikiryaka A.V., Pearton S.J. Structural and electrical properties of thick κ -Ga₂O₃ grown on GaN/sapphire templates // APL Materials. – 2022. – Т. 10. – № 6. – P. 061102.
DOI 10.1063/5.0091653.

8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты